

^{™™}激活氧氟化物红光荧光粉的研 究进展

AUTHOR(S):

姬,海鹏;张,宗涛;XU, Jian; TANABE, Setsuhisa;陈, 德良;解,荣军

CITATION:

姬,海鹏…[et al]. Mn⁴激活氧氟化物红光荧光粉的研究进展. 无机材料学报 2020, 35(8): 847-856

ISSUE DATE: 2020-08

URL: http://hdl.handle.net/2433/255615

RIGHT: 発行元の許可を得て掲載しています。





A Self-archived copy in Kyoto University Research Information Repository https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp

第35卷第8期 2020年8月

无机材料学报 Journal of Inorganic Materials Vol. 35 No. 8 Aug., 2020

文章编号:1000-324X(2020)08-0847-10

DOI: 10.15541/jim20190554

Mn⁴⁺激活氧氟化物红光荧光粉的研究进展

姬海鹏¹,张宗涛¹,XU Jian²,TANABE Setsuhisa²,陈德良¹,解荣军³

(1. 郑州大学 材料科学与工程学院, 郑州 450001; 2. Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University, Kyoto 606-8501, Japan; 3. 厦门大学 材料学院, 厦门 361000)

摘 要:稳定可靠的高光子能量发光(620~650 nm)红光荧光粉,对于构建低色温、高显指荧光粉转换型白光发光二极 管(WLED)至关重要。Mn⁴⁺激活红光荧光粉是当前 WLED 用荧光粉研究热点之一。本文介绍了 Mn⁴⁺离子的能级跃迁 与光致发光特性,详细叙述了目前所报道的七种 Mn⁴⁺激活含 d⁰/d¹⁰/s⁰ 离子氧氟化物系列红色荧光粉(如 Na₂WO₂F₄:Mn⁴⁺等)的制备方法、晶体结构及其发光特性。目前 Mn⁴⁺在氧氟化物结构中得到强 R 线(零声子线)发光的 情况少,微观配位体仍是[MnF₆]或[MnO₆],其化学稳定性和量子效率研究也很缺乏。最后对 Mn⁴⁺激活氧氟化物红光 荧光粉的研究进行了展望。

关 键 词: 白光 LED; 荧光粉; Mn⁴⁺; 氧氟化物; 综述

中图分类号: TQ174 文献标识码: A

Advance in Red-emitting Mn⁴⁺-activated Oxyfluoride Phosphors

JI Haipeng¹, ZHANG Zongtao¹, XU Jian², TANABE Setsuhisa², CHEN Deliang¹, XIE Rongjun³

(1. School of Materials Science and Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China; 2. Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University, Kyoto 606-8501, Japan; 3. School of Materials, Xiamen University, Xiamen 361000, China)

Abstract: The stable and reliable red phosphor with high-photon energy emission (620–650 nm) is critical for the fabrication of the phosphor-converted white light-emitting diode (WLED) with low correlated color temperature and high color rendering index. Mn^{4+} -activated phosphor is an emerging kind of red-emitting phosphor for WLED. Herein, the energy levels transition and photoluminescence characteristics of the Mn^{4+} ion were introduced; then, the preparation, crystal structure and luminescent properties of as-far reported seven kinds of Mn^{4+} -doped oxyfluoride red phosphors (such as $Na_2WO_2F_4:Mn^{4+}$) containing d^0 , d^{10} or s^0 cations were reviewed. Currently, only in quite rare case of oxyfluoride, Mn^{4+} was found to exhibit strong R-line emission, with local coordination remaining as either [MnF_6] or [MnO_6]. The studies on the chemical stability and quantum efficiency of Mn^{4+} -doped oxyfluoride phosphors are still insufficient. Finally, we prospected the future development of Mn^{4+} -doped oxyfluoride phosphor.

Key words: white LED; phosphor; Mn⁴⁺; oxyfluoride; review

白光发光二极管(White light-emitting diode, WLED)是一种正在迅速取代荧光灯和白炽灯的新

型高效半导体光源。获得白光有三种途径^[1-2]: (1) RGB 三色 LED 复合法; (2)蓝光 LED 复合黄/

- 作者简介: 姬海鹏(1989-), 男, 讲师. E-mail: jihp@zzu.edu.cn
- JI Haipeng (1989–), male, lecturer. E-mail: jihp@zzu.edu.cn

收稿日期: 2019-10-31; 收到修改稿日期: 2019-11-20

基金项目:国家自然科学基金(51902291);河南省博士后科研项目(19030025);中国博士后科学基金(2019M662524) National Natural Science Foundation of China (51902291); Postdoctoral Research Sponsorship in Henan Province (19030025); China Postdoctoral Science Foundation (2019M662524)

通讯作者: 陈德良, 教授. E-mail: dlchen@zzu.edu.cn; 解荣军, 教授. E-mail: rjxie@xmu.edu.cn CHEN Deliang, professor. E-mail: dlchen@zzu.edu.cn; XIE Rongjun, professor. E-mail: rjxie@xmu.edu.cn

第35卷

绿光和红光荧光粉法; (3)近紫外 LED 复合 RGB 荧光粉法。后两种白光器件称为荧光粉转换型 WLED, 其相关色温和显色指数很大程度上依赖红 光荧光粉^[3]。

目前 WLED 用红光荧光粉的激活离子主要有 Eu³⁺ (4f⁷-4f⁷ 禁戒跃迁)、Eu²⁺ (4f⁶5d¹-4f⁷5d⁰ 允许跃迁) 和 Mn⁴⁺ (3d³-3d³ 禁戒跃迁)。Eu³⁺激活红光荧光粉(如 Y₂O₃:Eu³⁺)主要激发跃迁为电荷迁移带跃迁,在近 紫外光区(<365 nm), 无法应用于蓝光 LED 泵浦的 WLED。Eu²⁺激活硫化物如 Sr_{1-x}Ca_xS:Eu²⁺(A_{em}: 600~ 650 nm, 光谱半高宽 FWHM: 1800~2000 cm⁻¹)的研 究较早^[4],但其化学性质不稳定,易与水和封装材 料反应。目前商业显示级 WLED 所用红光荧光粉主 要为Eu²⁺激活氮化物,如(Ba,Sr)₂Si₅N₈:Eu²⁺(λ_{em}: 590~ 625 nm, FWHM: 2050~2600 cm⁻¹)和(Ca,Sr)AlSiN₃: Eu²⁺ (λ_{em} : 610~660 nm, FWHM: 2100~2500 cm⁻¹)^[1,5]. 其量子效率很高,可被蓝光 LED 有效激发,化学稳 定性好。但其激发光谱超过 500 nm, 而与绿/黄粉共 封装时产生光谱重吸收,部分发射光子(>650 nm)落 在人眼明视觉敏感度较低波长范围; 合成需要高 温高压低氧环境(>1700 ℃,~1 MPa, N₂),条件苛 刻。2014 年, Schnick 等报道了 SrLiAl₃N₄:Eu²⁺ (λ_{em} =650 nm, FWHM=1180 cm⁻¹)^[6]和 Sr[Mg₃SiN₄]: Eu²⁺ (λ_{em}=615 nm, FWHM=1170 cm⁻¹)^[7], 其发光光谱 半高宽较窄,且发光热猝灭小,用于低色温高显色 WLED (如色温< 3000 K, 显色指数>90)封装时, 可 比传统低色温高显色 WLED 的流明效率提高 4%~12%;待其化学稳定性提高和成本降低后,在 商业红粉中的占比有望增大。近年来,美国 GE 公司 将 Mn⁴⁺激活 K₂SiF₆(KSF)荧光粉用于 WLED 并商业 化。Mn⁴⁺在 KSF 中表现出以 630 nm 为主峰、来自 于 v₆/v₄/v₃ 振动模式的发射峰^[8-9],每个发光峰都很 窄(FWHM<5 nm), 内量子效率高达 80%^[10]。由于 K₂SiF₆:Mn⁴⁺的窄带发光特征,目前其主要应用于液 晶显示背光源, 难以实现氮化物红光荧光粉封装所 得 WLED 的高显色指数而不能在多领域完全取代 后者。1972年欧司朗/GE公司^[11]报道了K₂SiF₆:Mn⁴⁺ 材料, 2009年GE申请了其与LED的组合使用专利 (US7497973B2 等)。目前我国没有掌握 KSF 类荧光 粉核心专利,产销受制于人。

在 K_2SiF_6 中, Mn–F 键的高电负性、低极化率 和低共价性使 ${}^{2}E_{g} \rightarrow {}^{4}A_{2g}$ 跃迁表现较高能量。F⁻作 为双给配体, 一方面向 Mn^{4+} 提供 p 轨道成 σ 键, 另 一方面又提供 p 轨道成 π 键, 有效中和 Mn^{4+} 的正电 子而形成稳定配体^[8]。由于 KSF 的窄带发光特征, 其发光光谱经过滤光片及液晶面板后依然有很高

色纯度^[12];利用 KSF 搭配 β -Sialon 窄带绿粉,已可 实现接近 OLED 面板色域。但 KSF 类荧光粉(指以 K_2SiF_6 为代表的 A_2MF_6 氟化物, A 为 L i ⁺ / K ⁺ / N a ⁺ / R b ⁺ / C s ⁺ / N H ^{4 +}; M 为 Si⁴⁺/Ge⁴⁺/Ti⁴⁺/Zr⁴⁺/Sn⁴⁺等)也存在以下劣势: (1)制备 过程用到强腐蚀性氢氟酸,环保压力大,需要专门 耐强酸设备;即使采用两步湿化学法也无法避免出 现杂相(如 KHF₂)^[10,13]; (2)化学稳定性相对差, 高温 (>150 ℃)下易分解失效; (3)在潮湿环境下, Mn⁴⁺易 潮解为 Mn³⁺ (如形成 KMnF₄·H₂O 和 K₂MnF₅·H₂O)^[13], 与 Mn⁴⁺形成竞争吸收而降低荧光粉量子效率; (4) Mn⁴⁺在 KSF 类基质中处于八面体反转中心, R线 跃迁强度非常弱, 对蓝光吸收强度低^[14], 易在大功 率 LED 辐照下出现吸收饱和。当前对于 Mn⁴⁺激活 氟化物荧光粉的研究主要有新组分开发、绿色制备 及表面包覆等。比如除 KSF 外, 相继开发了多种氟 化物荧光粉,包括 $A_2MF_6:Mn^{4+}$ (A为 L i ⁺ / K ⁺ / N a ⁺ / R b ⁺ / C s ⁺ / N H ^{4 +}; M 为 $Si^{4+}/Ge^{4+}/Ti^{4+}/Zr^{4+}/Sn^{4+})$ 、A₃MF₆:Mn⁴⁺ (A 为 Li⁺/K⁺/Na⁺, M 为 Al³⁺/Ga³⁺)和 AXF₆(6H₂O):Mn⁴⁺ (A 为 Ba^{2+}/Zn^{2+} , X 为 $Si^{4+}/Ge^{4+}/Ti^{4+}/Sn^{4+}$)等^[15]。

近年来也出现了一系列氧氟化物荧光粉的报 道。Mn⁴⁺激活氧氟化物荧光粉是一类化学稳定性更 高、组分新颖、具有 F⁻/O²配位而形成畸变八面体 的红光荧光粉,有望部分解决 KSF 类荧光粉的不 足。本文将从合成制备、晶体结构和荧光性质方面 综述目前 Mn⁴⁺激活氧氟化物荧光粉的研究进展。

1 Mn⁴⁺离子的能级与荧光性质

1.1 Mn⁴⁺离子的基态和激发态能级

图 1 给出 d 轨道的五种简并轨道的相对空间形状、其在八面体晶体场中的劈裂、d³ 自由离子能级及描述 d³离子在八面体晶体场中能级劈裂的 Tanabe-Sugano 图^[16]。当 Mn⁴⁺掺入固体晶格时,受晶体场影响,d 轨道发生能级劈裂。在八面体晶体场中,d_{z²}和d_{x²-y²} 电子云极大值与配体离子电子云迎头相碰而受到较大推斥,使该轨道能量升高; 而d_{xy}, d_{yz}, d_{xz} 电子云极大值插在配体之间,受到的推斥作用较小,轨道能量升高较少。因此 d 轨道能级劈裂为两组:一组能量高于 E_s 能级,称为 e_g 轨 道; 另一组能量低于 E_s 能级,称为 t_{2g} 轨道(如图 1(d)所示)。

 e_{g} 和 t_{2g} 轨道间能级差称为晶体场分裂能 Δ_{O} 。 在八面体晶体场中, Δ_{O} 较大, Mn^{4+} 的 3 个 d 电子可稳 定占据 3 个 t_{2g} 轨道,因此 Mn^{4+} 倾向占据八面体格











图 1 d³离子的自由离子能级(*C* = 4.5*B*) (a), 描述 d³离子在八面体晶体场中能级劈裂的 Tanabe-Sugano 图(*C* = 4.5*B*) (b), 八面体晶体场中五种 d 轨道相对于配体的取向(黑点表示配体离子)(c)和 d 轨道在八面体晶体场中的晶体场劈裂(d)^[16] Fig. 1 Energy levels arising from a d³ configuration for a free transition metal ion (*C*=4.5*B*) (a), Tanabe-Sugano diagram for the d³ electron configuration in an octahedral crystal field (*C*=4.5*B*) (b), orientation of the five d-orbitals with respect to the ligands of an octahedral complex (black dots showing the ligands around the transition metal ion) (c), and crystal field splitting for the d-orbitals in an octahedral crystal field (d)^[16]

位。⊿₀取决于过渡金属离子的氧化态、配体离子电 荷及两者间键长^[9]。过渡金属离子氧化态越高,其所 受晶体场劈裂一般越大; 而配位离子电荷增多或两者 间键长变短,则晶体场劈裂变大。Tanabe 和 Sugano^[17] 在考虑 d 电子和晶体场间的相互作用后计算了 d³ 自 由离子在八面体晶体场中的劈裂,示于图 1(b)。 Mn⁴⁺自由离子能级在八面体晶体场中劈裂为二个 或多个能级,由群论决定。由于过渡金属离子在晶 体场中劈裂后能级的能量受晶体场强度和 d 轨道电 子间相互作用的共同影响;因此, Tanabe-Sugano 图 的横纵坐标都除以 Racah 参数 B(描述 d 轨道电子间 相互作用, 一般为 500~1000 cm⁻¹)并假定 $C \approx 4.5B$ 。 由于 Mn⁴⁺具有较多正电荷而常受到强晶体场作用; 在八面体晶体场中, 其最低激发态能级为 ²E_e(²G); 该能级在 Tanabe-Sugano 图中几乎为一条平线, 不 受晶体场劈裂强度变化的影响。

当 Mn⁴⁺掺杂到晶体材料中时,除受晶体场效应 影响外,还受电子云扩展效应(Nephelauxetic effect) 影响^[18]。电子云扩展效应指金属阳离子与配体离子 成键后,其电子云比自由离子时的电子云更为扩散 而引起光谱性质变化的效应。由于金属离子的正电 荷被配位键中的负电荷中和而降低,d 轨道会有轻 微扩展,使得 d 轨道电子间排斥作用减弱而能量降 低,表现为 Racah 参数 B 和 C 在晶体中比其在自由 离子时有所减小。d 轨道电子的离域扩展受金属离 子与配体离子间所形成化学键的影响,该化学键中 共价键成分越多,离域扩展效应越显著,Racah 参数 减小越显著。Mn⁴⁺最低激发态能级 ²Eg 几乎与晶体 场效应无关,其能量仅由 Racah 参数 B 和 C 决定。

1.2 Mn⁴⁺离子能级跃迁与荧光性质

根据电偶极跃迁选律,只有符合宇称选择定则 (Δ*L*=±1)和自旋选择定则(Δ*S*=0)的跃迁才可发生。 Mn⁴⁺的能级跃迁发生在 d 轨道能级之间,为宇称禁 戒跃迁。此禁戒选律可通过与晶格振动(声子)的 耦合而部分放宽;此外,对于无反转中心的过渡金 属络合物,也可通过将奇宇称波函数混入 d 轨道波 函数的奇宇称晶体场函数分量而得到部分放宽^[19-20]。

Mn⁴⁺的激发是由 ⁴F 组态的 ⁴A_{2g}(电子构型 t_{2g}³)

能级跃迁到 ${}^{4}T_{2g}$ 或 ${}^{4}T_{1g}$ (电子构型 $t_{2g}{}^{2}e_{g}{}^{1}$)能级;根据 自旋选择定则,此激发跃迁为自旋允许跃迁。在 $K_{2}SiF_{6}:Mn^{4+}$ 中,此跃迁吸收表现为宽峰,分别位于 300~400 nm 和 400~500 nm;由图 1(b)可以看出, 该跃迁能量与晶体场强度密切相关。而 ${}^{2}E_{g}({}^{2}G) \rightarrow$ ${}^{4}A_{2g}({}^{4}F)$ 发光跃迁为自旋和宇称双重禁戒;由于电 子与声子耦合作用而部分解禁,表现为 610~650 nm 范围多个锐线窄带 Stokes 和 anti-Stokes 发射峰。

除 d-d 跃迁外, 在 Mn⁴⁺激活荧光粉中还存在着 配体离子与 Mn⁴⁺之间的电荷转移跃迁。电子从配体 离子转移到过渡金属离子过程, 伴随偶极矩的巨大 变化, 为完全允许跃迁, 因此荧光强度很高。此外, Mn⁴⁺和配体离子间的化学键合在电荷迁移激发时 发生显著变化; 由于化学键合的变化, 电荷迁移态 和基态势能曲线间存在很大的偏移而导致宽带吸 收。根据过渡金属离子和配体离子类型的不同, 电 荷迁移吸收带可在紫外或可见光区。

2 Mn⁴⁺激活氧氟化物荧光粉

2.1 Mn⁴⁺激活氧氟化物红光荧光粉的潜在优势

氧氟化物作为 Mn⁴⁺掺杂基质具有以下重要潜 在优势: (1)氧氟化物通常具有比氟化物更好的化学 稳定性, 且其制备过程不一定需要 HF 参与; (2)由于 Mn-O/Mn-F 键长不同而形成具有较大畸变和低点 群对称性的配位八面体, 且由于 O 和 F 原子质量不 同而热振动振幅和频率不同,因此更容易产生 Jahn-Teller 效应而放宽 Mn⁴⁺ d-d 电偶极跃迁选律限 制,得到强R线发光,并提高对蓝光LED的吸收效 率; (3) [MnF6-rOr]可以结合 Mn-F 离子键特性使 R 线和相关声子振动带在 630~650 nm 红光区以得到 较高流明效率。当 Mn⁴⁺处于八面体场反转中心(图 2(a))时, R 线发光强度非常弱。一旦 Mn4+所处环境 的局部对称性降低而失去反转对称中心,则宇称选 择规则将通过高能量奇宇称能态(如 3d²4p)的混入 而放宽, 使 R 线跃迁成为电偶极允许跃迁。氧氟化 物中,阳离子与 O^{2-}/F 离子间 $d\pi$ -pπ轨道成键作用不 同, 其八面体配位结构形成天然大畸变(图 2(b)~(d)); 当 Mn⁴⁺掺杂其中时, 其 R 线发光强度将可能远超来 自于反对称振动模式 v₆(T_{2u} bending)/v₄(T_{1u} bending)/ v₃(T_{1u} stretching)的发光峰, 而成为 Mn⁴⁺发光 光谱中最强峰。

2.2 Mn⁴⁺激活氧氟化物红光荧光粉的制备、晶体结构与荧光性质

目前国内外报道了七种 Mn⁴⁺激活氧氟化物荧



图 2 规则八面体配位和畸变八面体配位 Fig. 2 Regular octahedron coordination and distorted octahe-

dra coordination (a) Point symmetry of O_h ; (b) Central cation shifting to a vertex, C_{4v} ; (c) Central cation shifting to an edge, C_{2v} ; (d) Central cation shifting to a face, C_{3v}

光粉,分别为 $R_2WO_2F_4$: Mn^{4+} (R为Na,Cs),Cs₂NbOF₅: Mn⁴⁺,BaNbOF₅: Mn^{4+} ,Sr₂ScO₃F: Mn^{4+} ,BaTiOF₄: Mn⁴⁺,Mg₂₈Ge_{7.55}O₃₂F_{15.04}: Mn^{4+} 和LiAl₄O₆F: Mn^{4+} 。按 所含八面体配位阳离子电子构型可分为 d⁰离子 (W⁶⁺:[Xe]4f¹⁴5d⁰,Nb⁵⁺:[Kr]4d⁰,Sc³⁺:[Ar]3d⁰,Ti⁴⁺: [Ar]3d⁰),d¹⁰离子(Ge⁴⁺:[Ar]3d¹⁰)和 s⁰离子(Al³⁺: [Ne]3s⁰)三类,列于表 1。

 Mn^{4+} 离子 ${}^{4}A_{2g} \rightarrow {}^{4}T_{2g}$ 激发跃迁能量与晶体场劈 裂相关,而 ${}^{2}E_{g} \rightarrow {}^{4}A_{2g}$ 发光跃迁能量主要取决于电子 云扩展效应。目前学术界主流观点认为晶体场劈裂 取决于配位键键长和八面体畸变,而电子云扩展效 应与 Mn^{4+} -配体离子间离子键性/共价键性和八面体 畸变有关。因此,下文在介绍各氧氟化物荧光粉时, 也考察了 Mn^{4+} 在上述氧氟化物中的微观配位环境。

2.2.1 含 d⁰ 离子配位八面体的 R₂WO₂F₄:Mn⁴⁺

Hu 等^[21]采用共沉淀法制备了 Na₂WO₂F₄:Mn⁴⁺。 首先将 Na₂WO₄·2H₂O 在 HF 溶液中经磁力搅拌溶解, 然后放入适量实验室自制的 K₂MnF₆,并逐滴加入 作为沉淀剂的甲醇,所得沉淀物经洗涤、离心、干 燥得到 Na₂WO₂F₄:Mn⁴⁺。如图 3 所示,在 Na₂WO₂F₄ 中,W⁶⁺与 2 个 O²⁺+4 个 F⁻成键形成[WO₂F₄]²⁻,其点 群对称操作为 C_{2v}; 当 Mn⁴⁺取代 W⁶⁺时,其 ²E_g→ ⁴A_{2g}跃迁的 R 线位于 619 nm 处^[21]且 R 线发光强度 远高于 v₆/v₄/v₃振动模式发光强度(约为 v₆声子振动 发光峰强度的 125%)。考虑到 Mn⁴⁺在 Na₂WO₂F₄ 中 R 线发光能量与其在 K₂SiF₆中的一致,推测 Mn⁴⁺在 Na₂WO₂F₄ 中仍与 6 个 F⁻成键形成[MnF₆]²⁻八面体。



姬海鹏,等: Mn⁴⁺激活氧氟化物红光荧光粉的研究进展

表 1

目前所报道的 Mn⁴⁺激活氧氟化物荧光粉

ativated avyfluarida nh

KURENAI Kyoto University Research Information Repository

851

| Table 1 The reported with activated oxynuoride phosphors | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------|
| Cation | Phosphor host | Peaking wavelength/nm | (R-line/v6 intensity ratio)/% | $T_{50\%}/{ m K}$ | Ref. |
| d^0 | $Na_2WO_2F_4$ | 619 | 125 | 340 | [21-22] |
| | $Cs_2WO_2F_4$ | 632 | 5 | 350 | [23] |
| | Cs_2NbOF_5 | 632 | 10 | - | [24-25] |
| | BaNbOF ₅ | 629 | 10 | - | [26] |
| | Sr_2ScO_3F | 690 | - | 320 | [27] |
| | $BaTiOF_4$ | 632 | 5 | - | [28] |
| d^{10} | $Mg_{28}Ge_{7.55}O_{32}F_{15.04}$ | 657 | _ | 700 | [29] |
| s^0 | LiAl ₄ O ₆ F | 662 | 5-10 | - | [30] |



图 3 Na₂WO₂F₄的晶胞(a), 具有较大畸变的[WO₂F₄]八面体 (b)和 Na₂WO₂F₄:Mn⁴⁺的发光光谱(c)(插图为其在 460 nm 激 发下照片)^[21]

Fig. 3 Unit cell of $Na_2WO_2F_4$ (a), highly-distorted $[WO_2F_4]$ octahedra (b), and emission spectrum of $Na_2WO_2F_4$: Mn^{4+} (c)^[21] with inset showing phosphor image under 460 nm light Na: yellow; W: blue; O: red; F: gray

 Mn^{4+} 在 $Na_2WO_2F_4$ 中,在低温到室温区间的积分发 光强度几乎不变,而从室温开始其积分发光强度骤 减,在 340 K 时减弱为低温发光强度的一半^[21]。

Cai 等^[23]采用湿化学法制备了 Cs₂WO₂F₄:Mn⁴⁺。 首先将 Cs₂CO₃ 和 WO₃ 经 700 ℃煅烧 10 h 得到 Cs₂WO₄, 然后将其溶解于 HF 酸溶液中并加入适量 K₂MnF₆, 在通风橱内 50 ℃干燥 12 h, 所得产物经 乙醇洗涤数次, 得到 Cs₂WO₂F₄:Mn⁴⁺。

在 $Cs_2WO_2F_4$ 中, O^{2-}/F^{-} 占据同一晶体学格位(如 图 4(a)所示), 六个 W-(O,F)键键长相同; $[WO_2F_4]^{2-}$ 八面体所具有的较小畸变, 来自于 W-(O,F)键角的 不同, 如图 4(a)所示。当 Mn^{4+} 取代 W^{6+} 时, 由于需 要电荷平衡而不能形成 $[MnO_2F_4]^{2-}$, 而是与其在 K_2MnF_6 中一样与六个 F⁻形成 $[MnF_6]^{2-}$ 八面体^[23], 且形



图 4 (a) Cs₂WO₂F₄的晶体结构,其含有具有较小畸变的 W(O,F)₆配位八面体,右下所示为 Mn⁴⁺在 K₂MnF₆中的微观 配位八面体; (b) Cs₂WO₂F₄:Mn⁴⁺的激发与发射光谱(插图为 其在 365 nm 激发下照片)^[23]

Fig. 4 (a) Unit cell of $Cs_2WO_2F_4$ which contains slightlydistorted $[W(O,F)_6]$ octahedra, with the bottom-right showing the local coordination of Mn^{4+} in K_2MnF_6 ; (b) Excitation and emission spectra of $Cs_2WO_2F_4:Mn^{4+}$ with inset showing the phosphor image under 365 nm light^[23]

成的[MnF₆]具有较小的八面体畸变。因此,如图4(b) 所示,Mn⁴⁺在 Cs₂WO₂F₄中其 ${}^{2}E_{g} \rightarrow {}^{4}A_{2g}$ 跃迁(R 线) 位于 620 nm 处^[23]且 R 线跃迁强度很弱,与 Mn⁴⁺ 在 K₂SiF₆中的发光性质非常接近。但两者的激发光 谱有明显不同,计算得到的晶体场强度 10Dq 分别 为 21050 cm⁻¹ (Cs₂WO₂F₄:Mn⁴⁺)和 23900 cm⁻¹ (K₂SiF₆:Mn⁴⁺)^[23]。在 Cs₂WO₂F₄所含[WO₂F₄]八面体 中,W-O/F 键键长为 0.1889 nm,比 K₂SiF₆中所含 Si-F键的键长(0.1682 nm)长;预期 Mn⁴⁺在 Cs₂WO₂F₄



第35卷

中所形成的 Mn-F 键也比其在 K₂SiF₆ 中所形成 Mn-F 键长, 晶体场强度 10Dq 与金属离子--配体离 子间键长成反比, 因此, Mn⁴⁺取代 Cs₂WO₂F₄ 中 W⁶⁺ 离子时, 其所受晶体场强度较其取代 K₂SiF₆ 中的 Si⁴⁺时减弱, 因此 ${}^{4}A_{2g} \rightarrow {}^{4}T_{2g}$ 跃迁激发波长红移, 但 ${}^{2}E_{g} \rightarrow {}^{4}A_{2g}$ 发光跃迁几乎不受晶体场效应影响而保 持一致。Mn⁴⁺在 Cs₂WO₂F₄ 中的积分发光强度, 在 10~280 K 范围, 随温度升高而增强, 之后在 280~ 430 K 范围, 随温度升高而迅速降低。在约 350 K 时, 其积分发光强度减弱为最高积分发光强度时的一 半^[23], 因此热猝灭温度为 350 K。

2.2.2 含 d⁰ 离子配位八面体的 Cs₂NbOF₅:Mn⁴⁺

Ming 等^[25]采用离子交换再结晶法制备了 Cs₂NbOF₅:Mn⁴⁺。首先将 Nb₂O₅ 经水浴加热溶解于 HF 酸溶液中,然后加入适量 K₂MnF₆和 CsF,将混 合溶液持续搅拌 2 h 并陈化 8 h,最后将所得沉淀物 经离心收集并用冰醋酸和无水乙醇洗涤数次,在 70 ℃下干燥 3 h 得到 Cs₂NbOF₅:Mn⁴⁺。Wang 等^[24] 也报道了类似方法制备 Cs₂NbOF₅:Mn⁴⁺。

在 Cs₂NbOF₅中, Nb⁵⁺与 5 个 F⁺1 个 O²⁻形成畸 变[NbOF₅]²⁻八面体,且[NbOF₅]彼此孤立存在^[31]; 其晶体结构与 Cs₂ZrF₆相同^[31],但目前尚没有详细 的关于[NbOF₅]²⁻八面体中键长和键角的报道。如图 5 所示, Mn⁴⁺在 Cs₂NbOF₅中,相比于其在K₂SiF₆中时, ${}^{4}A_{2g} \rightarrow {}^{4}T_{2g}$ 跃迁激发波长红移;其 R 线发光强度很 弱,而最强发光峰来自于 v₆振动模式(632 nm)^[24-25]。 这可能与 Cs₂NbOF₅结构所含[NbOF₅]²⁻八面体呈孤 立出现有关;当 Mn⁴⁺取代 Nb⁵⁺时,为了补偿电价失 衡, O²⁻被 F⁻取代而形成[MnF₆]²⁻八面体,且由于晶 体结构中该八面体孤立存在而不易保持畸变,因此 呈现具有反转对称中心的[MnF₆]²⁻八面体。

2.2.3 含 d⁰ 离子配位八面体的 BaNbOF₅:Mn⁴⁺

Dong 等^[26]用离子交换再结晶法制备了 BaNbOF₅:Mn⁴⁺。将适量 BaF₂、Nb₂O₅、K₂MnF₆在 磁力搅拌下溶解于 HF 酸溶液中,将所得沉淀物离 心收集并用乙醇洗涤数次得到 BaNbOF₅:Mn⁴⁺。与 Cs₂WO₂F₄和 Cs₂NbOF₅ 晶体结构的配位八面体连接 方式类似,在 BaNbOF₅中 Nb⁵⁺与 5 个 F⁺+1 个 O²⁻ 形成畸变的彼此孤立存在的[NbOF₅]²⁻八面体^[32]。目 前尚没有该化合物中详细的关于[NbOF₅]²⁻八面体中 键长和键角的报道。如图 6 所示,当 Mn⁴⁺掺杂其中 时,其 R 线发光强度很弱,而最强发光峰来自于 v₆ 振动模式(629 nm)^[26],与其在 Cs₂NbOF₅中的发光特 性一致。在 BaNbOF₅结构中, [NbOF₅]²⁻八面体孤立 存在, [NbOF₅]²⁻八面体中的 O²⁻与 Ba²⁺成键,但当 Mn⁴⁺取代 Nb⁵⁺进行电荷补偿时,该 O²⁻被 F⁻取代而



图 5 Cs₂NbOF₅:Mn⁴⁺的激发光谱(PLE)与漫反射光谱(DRS) (a)和 Cs₂NbOF₅:Mn⁴⁺的变温发光光谱(b)^[24] Fig. 5 PLE and DRS spectra of the Cs₂NbOF₅:Mn⁴⁺ phosphor (a) and temperature-dependent emission spectra of Cs₂NbOF₅:Mn⁴⁺ (b)^[24] with the inset showing the intensity evolution of the integrated emission (I_e), the stokes emission (I_s) and the anti-stokes emmission (I_a)



图 6 T=78 和 298 K 时 BaNbOF₅:Mn⁴⁺的激发光谱(a)与发光 光谱(b) (插图为该荧光粉在自然光和紫外光照射下照片)^[26] Fig. 6 The PLE (a) and PL (b) spectra of the BaNbOF₅:Mn⁴⁺ phosphor at temperature of 78 and 298 K with insets showing the phosphor images under natural or UV light^[26]

形成畸变较小的 $[MnF_6]^{2-}$ 八面体,因此 R 线发光强 度依然很弱。其 ${}^{4}A_{2g} \rightarrow {}^{4}T_{2g}$ 跃迁激发波长具有较低 能量,位于 480 nm (20833 cm⁻¹)处。

2.2.4 含 d⁰ 离子配位八面体的 Sr₂ScO₃F:Mn⁴⁺

Kato 等^[27]用高温固相反应法制备了 Sr₂ScO₃F: Mn⁴⁺。以 SrCO₃、SrF₂、Sc₂O₃和 Mn(NO₃)₂·6H₂O 为 原料,充分研磨后于 1200 ℃下煅烧制得。如图 7(a) 所示,在 Sr₂ScO₃F 中, Sc³⁺与 5 个 O²⁺+1 个 F形成 ScO₅F 八面体^[27];如图 7(b)所示,Mn⁴⁺在 Sr₂ScO₃F 中表现出低光子能量发光且热猝灭现象严重。当 Mn⁴⁺取代 Sc³⁺时可能的电荷补偿机制是 O²⁻取代 F⁻ 而形成 MnO₆ 八面体;Mn–O 比 Mn–F 键具有更强的 共价键性,因此可解释 Mn⁴⁺在 Sr₂ScO₃F 中表现较 低 ${}^{2}E_{g} \rightarrow {}^{4}A_{2g}$ 跃迁能量(690 nm)^[27]。

2.2.5 含 d⁰ 离子配位八面体的 BaTiOF₄:Mn⁴⁺

Liang 等^[28]用水热和离子交换法制备了 BaTiOF₄:Mn⁴⁺。首先制备 K₂MnF₆ 作为 Mn 源, 然后 用水热方法以BaF2和H2TiF6为原料制备了BaTiOF4; 将BaTiOF4与适量K2MnF6混合并加入乙醇和HF酸 混合溶液, 过夜磁力搅拌后, 收集沉淀物并干燥, 即 得 BaTiOF₄:Mn⁴⁺。图 8(c)所示为 BaTiOF₄的晶体结 构,其晶胞中含有一种 Ti⁴⁺晶体学格位。由于 Ti-O 键的键长短于 Ti-F 键键长, 所以 Ti⁴⁺形成[TiO₂F₄] 畸变八面体配位结构; 如图 8(d)所示, Ti 偏离八面 体反转中心而偏向该八面体的一条边。在 BaTiOF₄ 中,只有 Ti⁴⁺格位可供 Mn⁴⁺占据;且该氧氟化物基 质与前述几种的不同在于,当 Mn⁴⁺取代 Ti⁴⁺时为等 价取代,因此非常可能在取代 Ti4+后保持原来的配 位环境不变,即形成[MnO₂F₄]。但从图 8(a)所示 BaTiOF₄: Mn⁴⁺的激发和发射光谱可以看出, 其最强 发光峰位于 631 nm 处, 来自于 v₆ 振动模式, 而 R 线 发光强度很弱。因此, Mn⁴⁺在 BaTiOF₄ 中掺杂后所



图 7 Sr₂ScO₃F 的晶胞(a)和 Sr₂ScO₃F:Mn⁴⁺的变温发光光谱(b)^[27] Fig. 7 Unit cell of Sr₂ScO₃F (a) and temperature-dependent emission spectra of Sr₂ScO₃F:Mn⁴⁺ (b)^[27] Sr: yellow; Sc: blue; O: red; F: gray



图 8 BaTiOF₄:Mn⁴⁺的室温激发与发射光谱(a), BaTiOF₄:Mn⁴⁺ 的室温和低温发光光谱(b), BaTiOF₄ 的晶胞(c)和[Ti₂OF₄]畸 变八面体(d)^[28]

Fig. 8 Excitation and emission spectra of $BaTiOF_4:Mn^{4+}$ at room temperature (a), emission spectra of $BaTiOF_4:Mn^{4+}$ at 77 K and 293 K (b), unit cell of $BaTiOF_4$ (c), and distorted octahedron coordination of $[Ti_2OF_4]$ (d)^[28] Ba: yellow; Ti: blue; O: red; F: gray

形成的微观配位环境极有可能是具有反转中心的 [MnF₆]八面体,而非预期的[MnO₂F₄]八面体。当冷 却到 77 K 时,其发射光谱中只表现出 v₆/v₄/v₃振动 模式的 Stokes 发光峰(图 8(b))。其积分发光强度从 20 ℃至 120 ℃之间逐渐增强,而在其后骤降,在 160 ℃时降为室温发光强度的一半^[28]。

2.2.6 含 d¹⁰ 离子配位八面体的 Mg₂₈Ge_{7.55}O₃₂F_{15.04}:Mn⁴⁺

商业 Mn⁴⁺激活荧光粉中,除用于 WLED 的 K₂SiF₆:Mn⁴⁺外,还有一种用于高压汞蒸气灯和荧光 灯的 Mg₂₈Ge_{7.55}O₃₂F_{15.04}:Mn⁴⁺。其可由 MgO、MgF₂ 和 GeO₂ 经高温固相反应法制备:将上述原料研磨 均匀后转移到带盖的铂坩埚中在1100 ℃下煅烧1h,再次研磨后于 1200 ℃下煅烧 16 h 即得^[33]。

 $Mg_{28}Ge_{7.55}O_{32}F_{15.04}$ 晶胞中共含六种 Mg^{2+} 和三 种 Ge^{4+} 格位。其中, Ge1 与 6 个 O²⁻形成八面体配位, 而 Ge2 或 Ge3 分别与 O²⁻或 F⁻形成四面体配位; 且 在这三种 Ge 格位中,实际上只有 38.8%的 Ge3 格位 有 Ge⁴⁺离子占据。因此 Mn⁴⁺只可能占据 Ge1 格位^[29]。 六种 Mg^{2+} 格位都形成八面体配位,但其成键情况不 同,分别为: Mg1/Mg3/Mg6 与 4 个 O²⁻+2 个 F⁻成键, Mg2 与 6 个 O²⁻成键, Mg4 与 3 个 O²⁻+3 个 F⁻成键, Mg5 与 5 个 O²⁻+1 个 F⁻成键^[29]。Mn⁴⁺取代 Ge⁴⁺时 为等价取代,而取代 Mg^{2+} 时需产生间隙阴离子或阳



无机材料学报

第35卷

离子空位等进行电荷补偿。Brik 等^[29]通过电荷交换 模型研究了 Mn^{4+} 在 $Mg_{28}Ge_{7.55}O_{32}F_{15.04}$ 的倾向占据 格位:通过计算 ${}^{4}T_{2g}$ 和 ${}^{4}T_{1g}$ 三重态在上述七种八面 体格位中的劈裂并与实测 ${}^{4}A_{2g} \rightarrow {}^{4}T_{2g}$ 和 ${}^{4}A_{2g} \rightarrow {}^{4}T_{1g}$ 激发光谱相比较(图 9),排除了 Mn^{4+} 占据 Mg1/Mg3/Mg4/Mg6格位的可能;再考虑到电荷平 衡后认为 Mn^{4+} 在该化合物中最倾向占据 Ge1 而次

倾向于占据 Mg2 格位。考虑到此两个格位都只与六 个 O^{2-} 形成八面体,因此 Mn⁴⁺在该基质中的微观配 位依然是[MnO₆]。Mn⁴⁺在该基质中最大发光峰波长 为 657 nm^[29],其热猝灭温度高达 700 K,远高于 K₂SiF₆:Mn⁴⁺荧光粉 558 K 的热猝灭温度^[34]。在 Mg₂₈Ge_{7.55}O₃₂F_{15.04}中 ⁴A_{2g}→⁴T_{2g} 跃迁能量较高 (23640 cm⁻¹),在假定势能曲线的曲率和平衡位置



图 9 Mn⁴⁺占据 Mg₂₈Ge_{7.55}O₃₂F_{15.04}结构中八面体配位 Ge/Mg 格位时计算所得 ⁴T_{2g}和 ⁴T_{1g}能级位置与实测光谱的比较^[29] Fig. 9 Comparison of the calculated Mn⁴⁺ energy levels in Mg₂₈Ge_{7.55}O₃₂F_{15.04} for all possible Mn⁴⁺ positions in Ge/Mg sites with the measured spectrum^[29]

第8期

A Self-archived copy in Kyoto University Research Information Repository https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp

姬海鹏,等: Mn⁴⁺激活氧氟化物红光荧光粉的研究进展

855



图 10 LiAl₄O₆F 的晶胞及 Al³⁺/Li⁺的配位多面体(a)和 LiAl₄O₆F:Mn⁴⁺的变温发光光谱(b)^[30]

Fig. 10 Unit cell of $LiAl_4O_6F$ and coordination of Al^{3+}/Li^+ (a) and emission spectra of $LiAl_4O_6F$:Mn⁴⁺ at temperature of 298–523 K (b)^[30]

不随晶体结构改变的情况下,较高的⁴T_{2g}能级位置 使得发生非辐射跃迁所需活化能较高^[34]。

2.2.7 含 s⁰ 离子配位八面体的 LiAl₄O₆F:Mn⁴⁺

Wang 等^[30]用高温固相反应法制备了 LiAl₄O₆F: Mn⁴⁺。以 LiF、Al₂O₃、MnCO₃为原料,充分研磨后 于 750~800 ℃下煅烧 8 h 即得。如图 10(a)所示, LiAl₄O₆F 结构中同时存在 AlO₄四面体和 AlO₆八面 体; 当掺杂 Mn⁴⁺时,其取代占据 AlO₆八面体中 Al³⁺ 格位^[30]。这与 Mn⁴⁺在其他铝酸盐如 Sr₄Al₁₄O₂₅、 CaAl₁₂O₁₉、BaMgAl₁₀O₁₇等中占据 AlO₆八面体时配 位情况相似,即形成[MnO₆]八面体配位;由于 Mn–O键的高共价键性,因此 Mn⁴⁺在 LiAl₄O₆F 中其 ²E_g→⁴A_{2g}跃迁在 662 nm 附近(图 10(b))。该荧光粉 的热猝灭性较差,加热到 398 K 时,其发光强度约 降至室温发光强度的一半。

3 总结与展望

氧氟化物中所含有的配位八面体具有天然大畸变,有助于放宽宇称跃迁选律,因此 Mn⁴⁺激活氧氟 化物荧光粉,有望作为一类组分新颖、化学稳定性 好、具有更高 d-d 跃迁几率和强 R 线发光的暖白光 WLED 用红光荧光粉,具有研究价值。

在目前所报道的七种 Mn⁴⁺激活氧氟化物荧光粉 中, Mn⁴⁺在微观配位上仍是与六个 F⁻形成[MnF₆]八 面体或与六个 O²⁻形成[MnO₆]八面体,并未同时与

O²⁻/F⁻离子形成化合键; 而且只在 Na₂WO₂F₄ 这一种 氧氟化物基质中实现了强R线发光。此外,目前所报 道的七种 Mn⁴⁺激活含 d⁰/d¹⁰/s⁰ 离子氧氟化物荧光粉 仍无法与商业 K₂SiF₆:Mn⁴⁺荧光粉相媲美且研究结果 不足, 表现在如下六个方面: 1)当前 Mn⁴⁺激活氧氟化 物荧光粉的研究主要集中在不等价取代较大离子半 径阳离子如 W⁶⁺/Nb⁵⁺等, 而在 Al³⁺/Ge⁴⁺等小离子半 径取代氧氟化物中的研究较少。Mn⁴⁺所取代阳离子 的离子半径会影响其晶体场效应 10Dq 的大小, 进而 影响⁴T₂,能级位置。2)当前所报道的 Mn⁴⁺激活氧氟 化物荧光粉的耐热猝灭性普遍较差(这可能与⁴T_{2g}能 级位置较低有关)。3)Mn⁴⁺掺杂在氧氟化物中所形成 的微观配位体没有明确确定, 甚至 Mn⁴⁺到底是否能 够形成同时与 F⁻和 O²⁻配位的畸变八面体都不确定。 Mn⁴⁺在同时与 O²⁻/F⁻成键配位时其光谱特性(²E_e→ ⁴A2g 跃迁能量、R 线发光强度与 v₆/v₄/v₃ 振动模式发 光强度的比例)与 O²⁻/F 离子的排列和数量关系之间 的制约关系更是不明。4)Mn⁴⁺掺杂氧氟化物荧光粉的 化学稳定性(基质吸潮变质和所掺杂 Mn4+离子吸潮 变价)是否优于 Mn⁴⁺激活氟化物(尤其是在氧氟化物 中形成[MnF₆]配位时),没有相关研究结果报道。5) 目前 Mn⁴⁺掺杂商业氟化物红光荧光粉的内量子效率 很高,但因 d-d 跃迁的宇称禁戒特性而导致外量子效 率不高。理论上通过降低 Mn⁴⁺局域配位结构对称性 可放宽宇称禁戒选律、提高 d-d 跃迁几率,进而提高 外量子效率。但目前所研究的 Mn⁴⁺激活氧氟化物荧 光粉,其内/外量子效率鲜有报道。6)商业 $K_2SiF_6:Mn^{4+}$ 氟化物荧光粉的荧光寿命 τ 约为 8 ms, 远长于商业 Eu²⁺激活氮化物荧光粉 µs 级寿命, 用于 需要快速响应的背光源时可能会出现画面残影现象; Mn⁴⁺在氧氟化物中具有畸变八面体配位的低对称性 格位取代,其荧光寿命如何变化,目前鲜有报道。

如今,理论计算和机器学习等已成为材料研究 的一种重要的先行研究手段。能否通过密度泛函理 论等计算方法,计算 Mn^{4+} 在与 O/F 同时配位时的稳 定性及其发光能量与 O/F 数量和相对空间位置的关 系,值得关注。尤其是现在 Mn^{4+} 的跃迁发光能量在 630~650 nm 之间没有报道, Mn^{4+} 在什么样的氧氟化 物基质中能否实现这种发光能量,值得探索。此外, 作者认为,未来 Mn^{4+} 激活氧氟化物荧光粉研发应予 以关注的研究内容有:1)合成制备多种新型 Mn^{4+} 激 活氧氟化物红光荧光粉,掌握其可控制备方法及 Mn^{4+} 的稳定有效掺杂方法;2)探索氧氟化物基质中 不同 O/F 配位(相对排列和数量关系)对 $Mn^{4+2}E_g \rightarrow$ $^{4}A_{2g}$ 跃迁能量和能级劈裂的影响规律;3)探明氧氟 化物基质中 $Mn^{4+2}E_g \rightarrow ^{4}A_{2g}$ 热致猝灭的发生机理和



URENAI M

856

影响因素; 4)了解 Mn⁴⁺激活氧氟化物的化学稳定性 和使用稳定性, 为其实际使用提供实验依据; 5)测 试所研发 Mn⁴⁺激活氧氟化物荧光粉的内/外量子效 率, 研发荧光寿命短、高吸收效率和量子效率的氧 氟化物荧光粉。

参考文献:

- WANG L, XIE R J, SUEHIRO T, *et al.* Down-conversion nitride materials for solid state lighting: recent advances and perspectives. *Chemical Reviews*, 2018, **118(4)**: 1951–2009.
- [2] XIA Z, LIU Q. Progress in discovery and structural design of color conversion phosphors for LEDs. *Progress in Materials Science*, 2016, 84: 59–117.
- [3] LIN C C, MEIJERINK A, LIU R S. Critical red components for next-generation white LEDs. *Journal of Physical Chemistry Letters*, 2016, 7(3): 495–503.
- [4] HU Y, ZHUANG W, YE H, et al. Preparation and luminescent properties of (Ca_{1-x}Sr_x)S:Eu²⁺ red-emitting phosphor for white LED. Journal of Luminescence, 2005, 111(3): 139–145.
- [5] XIE R J, HINTZEN H T. Optical properties of (oxy)nitride materials: a review. *Journal of the American Ceramic Society*, 2013, 96(3): 665–687.
- [6] PUST P, WEILER V, HECHT C, et al. Narrow-band red-emitting Sr[LiAl₃N₄]:Eu²⁺ as a next-generation LED-phosphor material. *Nature Materials*, 2014, **13(9):** 891–896.
- [7] SCHMIECHEN S, SCHNEIDER H, WAGATHA P, et al. Toward new phosphors for application in illumination-grade white pc-LEDs: the nitridomagnesosilicates Ca[Mg₃SiN₄]:Ce³⁺, Sr[Mg₃SiN₄]:Eu²⁺, and Eu[Mg₃SiN₄]. *Chemistry of Materials*, 2014, 26(8): 2712–2719.
- [8] ADACHI S. Photoluminescence spectra and modeling analyses of Mn⁴⁺-activated fluoride phosphors: a review. *Journal of Luminescence*, 2018, **197**: 119–130.
- [9] ADACHI S. Mn⁴⁺-activated red and deep red-emitting phosphors. ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2020, 9(1): 016001–1–34.
- [10] SIJBOM H F, VERSTRAETE R, JOOS J J, et al. K₂SiF₆:Mn⁴⁺ as a red phosphor for displays and warm-white LEDs: a review of properties and perspectives. *Optical Materials Express*, 2017, 7(9): 3332–3365.
- [11] PAULUSZ A G. Efficient Mn(IV) emission in fluorine coordination. Journal of the Electrochemical Society, 1973, 120(7): 942–947.
- [12] LIU Y H, GAO W, CHEN G T, et al. Research progress and development trend of fluoride phosphor for white LED. China Light & Lighting, 2018(2): 20–24.
- [13] VERSTRAETE R, SIJBOM H F, KORTHOUT K, et al. K₂MnF₆ as a precursor for saturated red fluoride phosphors: the struggle for structural stability. *Journal of Materials Chemistry C*, 2017, 5(41): 10761–10769.
- [14] ZHOU Z, ZHOU N, XIA M, et al. Research progress and application prospects of transition metal Mn⁴⁺-activated luminescent materials. *Journal of Materials Chemitry C*, 2016, 4(39): 9143–9161.
- [15] ZHOU Y Y, WANG L Y, DENG T T, et al. Recent advances in Mn⁴⁺-doped fluoride narrow-band red-emitting phosphors. *Scientia Sinica Technologica*, 2017, 47(11): 1111–1125.
- [16] TIM S. New Narrow Band Red Phosphors for White Light Emitting Diodes. Utrecht: Doctoral Dissertation of Utrecht University,

2018.

- [17] TANABE Y, SUGANO S. On the absorption spectra of complex ions II. *Journal of the Physical Society of Japan*, 1954, 9: 766–779.
- [18] BRIK M G, CAMARDELLO S J, SRIVASTAVA A M. Spin-forbidden transitions in the spectra of transition metal ions and nephelauxetic effect. *ECS Journal of Solid State Science and Technology*, 2016, 5(1): R3067–R3077.
- [19] BRIK M G, BEERS W W, COHEN W, et al. On the Mn⁴⁺ R-line emission intensity and its tunability in solids. *Optical Materials*, 2019, **91**: 338–343.
- [20] JI H, UEDA J, BRIK M G, et al. Intense deep-red zero phonon line emission of Mn⁴⁺ in double perovskite La₄Ti₃O₁₂. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2019, **21(45)**: 25108–25117.
- [21] HU T, LIN H, CHENG Y, et al. A highly-distorted octahedron with a C_{2v} group symmetry inducing an ultra-intense zero phonon line in Mn⁴⁺-activated oxyfluoride Na₂WO₂F₄. Journal of Materials Chemistry C, 2017, 5(40): 10524–10532.
- [22] CAI P, WANG X, SEO H J. Excitation power dependent optical temperature behaviors in Mn⁴⁺ doped oxyfluoride Na₂WO₂F₄. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2018, **20**(3): 2028–2035.
- [23] CAI P, QIN L, CHEN C, et al. Luminescence, energy transfer and optical thermometry of a novel narrow red emitting phosphor: Cs₂WO₂F₄:Mn⁴⁺. Dalton Transcations, 2017, 46(41): 14331–14340.
- [24] WANG Q, YANG Z, WANG H, et al. Novel Mn⁴⁺-activated oxyfluoride Cs₂NbOF₅:Mn⁴⁺ red phosphor for warm white lightemitting diodes. Optical Materials, 2018, 85: 96–99.
- [25] MING H, ZHANG J, LIU L, et al. A novel Cs₂NbOF₅:Mn⁴⁺ oxyfluoride red phosphor for light-emitting diode devices. *Dalton Transcations*, 2018, 47(45): 16048–16056.
- [26] DONG X, PAN Y, LI D, et al. A novel red phosphor of Mn⁴⁺ ion-doped oxyfluoroniobate BaNbOF₅ for warm WLED applications. CrystEngComm, 2018, 20(37): 5641–5646.
- [27] KATO H, TAKATA Y, KOBAYASHI M, et al. Photoluminescence properties of layered perovskite-type strontium scandium oxyfluoride activated with Mn⁴⁺. Frontiers in Chemistry, 2018, 6: 467.
- [28] LIANG Z, YANG Z, TANG H, et al. Synthesis, luminescence properties of a novel oxyfluoride red phosphor BaTiOF₄:Mn⁴⁺ for LED backlighting. Optical Materials, 2019, 90: 89–94.
- [29] BRIK M G, SRIVASTAVA A M. A computation study of site occupancy in the commercial Mg₂₈Ge_{7.55}O₃₂F_{15.04}:Mn⁴⁺ phosphor. *Optical Materials*, 2016, 54: 245–251.
- [30] WANG Q, LIAO J, KONG L, et al. Luminescence properties of a non-rare-earth doped oxyfluoride LiAl₄O₆F:Mn⁴⁺ red phosphor for solid-state lighting. *Journal of Alloys and Compounds*, 2019, 772: 499–506.
- [31] SRIVASTAVA A M, ACKERMAN J F. Synthesis and luminescence properties of Cs₂NbOF₅ and Cs₂NbOCl₅ with isolated [NbOX₅]⁻² (X=F⁻, Cl⁻) octahedra. *Materials Research Bulletin*, 1991, 26(6): 443–448.
- [32] SRIVASTAVA A M, ACKERMAN J F. Synthesis and luminescence properties of barium niobium oxide fluoride (BaNbOF₅) with isolated [NbOF₅]²⁻ octahedra. *Chemitry of Materials*, 1992, 4(5): 1011–1013.
- [33] BLESS P W, VON DREELE R B, KOSTINER E, et al. Anion and cation defect structure in magnesium fluorogermanate. *Journal of Solid State Chemistry*, 1972, 4(2): 262–268.
- [34] BEERS W W, SMITH D, COHEN W E, et al. Temperature dependence (13-600 K) of Mn⁴⁺ lifetime in commercial Mg₂₈Ge_{7.55}O₃₂F_{15.04} and K₂SiF₆ phosphors. *Optical Materials*, 2018, 84: 614–617.